

Silicon Diode

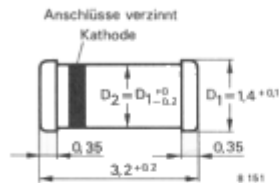
BA682

35V / 100mA

DATASHEET

OEM – Telefunken

Source: Telefunken Databook 1988

BA 682 · BA 683**Silizium-Planar-Dioden****Anwendungen:** Bereichsumschaltung in VHF-Tunern**Abmessungen in mm**

Glasgehäuse
SOD 80
Mini MELF
Gewicht max. 0,1 g

Absolute Grenzdaten

Sperrspannung	U_R	35	V
Durchlaßstrom	I_F	100	mA
Sperrschichttemperatur	T_j	150	°C
Lagerungstemperaturbereich	T_{stg}	- 55 ... + 150	°C

Maximaler Wärmewiderstand

Sperrschicht-Umgebung auf Leiterplatte 50 mm x 50 mm x 1,6 mm	R_{thJA}	500	K/W
------------------------------------------------------------------	------------	-----	-----

Kenngrößen

		Min.	Typ.	Max.	
$T_j = 25\text{ °C}$					
Durchlaßspannung $I_F = 100\text{ mA}$	U_F			1	V
Sperrstrom $U_R = 20\text{ V}$	I_R			50	nA
Diodenkapazität $f = 100\text{ MHz}, U_R = 1\text{ V}$	C_D			1,5	pF
$U_R = 3\text{ V}$	C_D			1,25	pF
	C_D			1,2	pF
Differentieller Durchlaßwiderstand $f = 200\text{ MHz}, I_F = 3\text{ mA}$	r_t			0,7	Ω
	r_t			1,2	Ω
$I_F = 10\text{ mA}$	r_t			0,5	Ω
	r_t			0,9	Ω
Sperrimpedanz $U_R = 1\text{ V}, f = 100\text{ MHz}$	z_r	100			k Ω

BA 682 · BA 683

